

9.3.1	プラズマと生成反応	264
9.3.2	装置の基本構成と反応室の電極構造	264
9.4	光 CVD, Photo CVD	267
9.5	MOCVD, Metalorganic CVD	269
9.6	メタル CVD	272
9.6.1	タングステン CVD	272
9.6.2	Al-CVD	274
9.6.3	Cu-CVD	277
9.6.4	バリヤメタル, TiN CVD	278
9.7	半球状グレインポリシリコン-CVD, HSG-CVD	280
9.8	強誘電体の CVD	282
9.9	低誘電率薄膜の CVD	284

第 10 章 エッチング

10.1	ウェットエッチング	292
10.2	プラズマエッチング・励起ガスエッチング (円筒形エッチング)	295
10.2.1	原理	295
10.2.2	装置	298
10.3	リアクティブイオンエッチング, スパッタエッチング (平行平板形・ECR 形・マグネトロン形エッチング)	299
10.3.1	原理と特徴	299
10.3.2	装置	303
10.3.3	ソフトウェア	304
10.3.4	Cu のエッチング	311
10.4	リアクティブイオンエッチング, スパッタイオンビーム エッチング (イオンビーム形エッチング)	314
10.4.1	極細イオンビーム機器, Focused Ion Beam: FIB 機器	315
10.4.2	直径 1 mm 程度のビーム機器	316
10.4.3	太いビーム機器	319
10.5	マイクロマシンの加工	322
10.6	エッチング用プラズマ源の開発	324

第 11 章 平坦化技術

11.1	平坦化技術の必要性	329
11.2	平坦化技術の概要	331